

证券代码：300656

证券简称：民德电子

## 深圳市民德电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-01

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>线上/电话会议</u>
参与单位名称	前海开源基金、博时基金、鲲鹏资本、兴业基金、申万菱信基金、平安养老保险、平安资管、华泰柏瑞、摩根基金、银华基金、汇添富基金、友邦人寿保险、歌汝基金、东方红资管、华西证券、中泰证券、东方财富证券
时间	2026年2月2日-2月9日
地点	公司会议室，线上会议，上海
上市公司接待人员姓名	董事兼 AiDC 事业部总经理：高健 董事会秘书：陈国兵
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、请介绍下晶圆代工厂广芯微电子目前产能情况，以及未来产能规划？</b></p> <p>答：广芯微电子将聚焦于特色高压功率半导体器件及功率集成电路晶圆代工业务，一期规划产能为 6 英寸硅基功率器件月产 10 万片，目前处于良性扩产阶段，产出自 2025 年初的 6,000 片/月提升至年底的 4 万片/月。</p> <p>广芯微电子目前已量产的产品主要有 MOS 场效应二极管（Mos Field Effect Rectifier, MFER）和垂直双扩散金属氧化物半导体场效应管（Vertical Double-diffused MOSFET, VDMOS），其中 MFER (45V-200V) 是最早实现量产的产品，月产出约 1.2 万片，VDMOS (60V-2,000V) 月产出约 2.6 万片，主要集中在 900V-1,700V 特高压与 60-200V 高可靠性平面低压产品。其他已小批量生产的产品包括：瞬态电压抑制二极管（Transient Voltage Suppressor, TVS）、高附加值的 1,200V 特高压 SmartMOS，以及与晶睿电子协同开发的多层外延高性能超结（Super Junction, SJ）MOSFET。同时，公司的 700V 高压 BCD 产品工程阶段也取得了重大进展，将在 2026 年释放产能，与芯微泰克合作开发的 1,200V 背道激光退火超薄片 IGBT 产品也在进行工程批试样。</p> <p>广芯微电子已具备丰富的产品线和工艺平台，并在不断开发和完善；同时，广芯</p>

微电子已预留二期项目用地，后续会根据一期项目进展情况，适时启动二期项目建设。

## **2、广芯微电子的产线为 6 英寸，与 8/12 英寸产线相比是否有市场竞争力？**

答：（1）功率半导体行业普遍具有“小批量、多品种、定制化”的典型特征，相较于大尺寸晶圆产线，6 英寸产线在应对多样化、快速迭代的产品需求时，具备天然的生产柔性与经济性优势；在性能与可靠性层面，6 英寸晶圆因尺寸更小，在同等厚度条件下具备更优的结构强度与稳定性，特别是在高压/特高压、大功率半导体产品方面，其性能保障和可靠性更高、适配性更强。

（2）AI 产业浪潮正深刻重塑全球半导体产能布局，伴随 AI 算力芯片的需求激增，台积电、三星等国际大厂纷纷将产能资源向利润更高、需求更旺的先进制程倾斜，主动收缩成熟制程及 6、8 英寸产线产能；功率半导体作为 AI 数据中心、电力系统建设、清洁能源及工业控制等核心领域的关键器件，市场对高压、高效、高可靠功率器件的需求持续升温。因此，台积电、三星等国际大厂的产能调整进一步加剧了全球成熟制程供给缺口，功率半导体晶圆代工需求持续扩大，也为国内成熟制程晶圆厂带来一轮难得的客户导入机会与盈利弹性。

## **3、广芯微电子有哪些竞争优势？**

答：广芯微电子核心竞争力主要体现在：

**（1）纯晶圆代工的商业模式定位：**纯晶圆代工模式在行业内属于相对稀缺资源，功率半导体设计公司的痛点，在于找到可以保障其知识产权安全且能为其提供稳定、可靠产能的晶圆代工厂；国内大部分功率半导体晶圆厂都是 IDM 模式或半 IDM 模式（即一部分自主品牌，一部分对外代工），很难做到对客户知识产权的充分保障和产能稳定供应。因此，具备原创设计能力的芯片设计公司非常有意愿与广芯微建立代工合作。

**（2）较高端的工艺平台能力和一体化解决方案：**广芯微电子的设备配置在国内 6 英寸功率半导体晶圆厂中具备较强的制造水平，已开发搭建的深沟槽刻蚀工艺、通孔刻蚀+钨淀积工艺及高能注入机台工艺等核心工艺平台能力属业内较高端的平台，产品线丰富，尤其在高压、特高压领域具有一定的优势；同时，广芯微和芯微泰克可以为客户提供正面+背道（超薄、背面加工、重金属掺杂等）一体化的特色工艺全套解决方案，可覆盖大多数功率半导体器件及功率集成电路产品，并利用自身丰富的经验，赋能设计公司，减少开发周期。

	<p><b>4、广芯微电子产品下游应用领域主要在哪些方面？</b></p> <p>答：广芯微电子聚焦于特色高压功率半导体器件及功率集成电路晶圆代工业务，特别是高压、大功率等高可靠性器件的生产制造，主要面向 AI 数据中心大功率电源、特高压电力设施、光储及工业逆变器、汽车电子和大型工控电机等下游领域对高压、大功率器件的需求。广芯微电子已获得 IATF16949:2016（国际汽车行业质量管理体系）符合证明函，具备车规级产品的生产能力。</p> <p><b>5、功率半导体当前的市场发展趋势如何？</b></p> <p>答：功率半导体市场正步入新一轮上升周期。一方面，随着 AI 大模型算力呈指数级攀升，大型 AI 数据中心用电规模逐步迈入吉瓦级，供电能力成为制约 AI 技术规模化落地的核心瓶颈，市场对高压、高效、高可靠功率器件的需求持续升温，电源管理（PMIC）与功率器件等成熟制程晶圆需求呈指数级增长；同时，光伏储能、电网升级改造等电力系统建设加速推进，工业自动化升级推动工控设备迭代，也在推动包括清洁能源及工业控制等核心领域的关键功率器件需求持续攀升。另一方面，台积电、三星等国际大厂均聚焦资源投入回报率更高的先进制程，以扩大 AI 算力和存储相关 12 英寸晶圆加工产能，并逐步减少 6、8 英寸成熟制程的资源供给和产能。这种需求结构性上行撞上供给侧硬收缩，直接导致了 6、8 英寸成熟制程产能的供需天平失衡。2025 年下半年以来，国内大部分功率晶圆产线均处于较高产能利用率水平，国际功率半导体巨头英飞凌也于 2026 年 2 月宣布将于 4 月 1 日起上调部分功率器件价格，行业呈现量价稳步提升的发展趋势。</p> <p><b>风险提示：</b>本记录表如有涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等方面前瞻性的陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026-02-09